

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2017年12月22日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 中村 孝
Vice Chair 吉本 昌広

下記の通り、第17回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」を開催致します。
会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名: 第17回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
主 催: IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter
日 時: 2018年1月29日(月) 10:20~15:50
会 場: 龍谷大学大阪梅田キャンパス
場 所: 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14階

プログラム: 次ページ以降参照
公用語: 日本語
会 費: 無料(事前登録不要)

[お問い合わせ先]
IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 西原 道哲 (立命館大学; mnishihara@ieee.org)

=====
<ご講演頂く皆様へ>

講演時間: 20分 + 質疑: 5分 (全て日本語)

使用器具: 講演で使用していただくPCは原則ご持参ください。もしご都合が悪いようでしたら、事前に鎌倉(阪大; kamakura@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp)までご連絡ください。その場合、Power Pointデータを事前に上記アドレス宛お送りいただくか、当日USBスティックメモリをご持参ください。
当日、特別な資料をご用意いただく必要はありません。

開会挨拶 [10:20 - 10:25]

中村 孝（ローム）

Session I. Power and Compound Semiconductor Devices [10:25 - 11:40]

座長：古橋 壮之（三菱電機）

- 10:25 Normally-off operation of planar GaN MOS-HFET without using etching process [SSDM]
T. Nanjo, T. Hayashida, H. Koyama, A. Imai, A. Furukawa, M. Yamamuka
Mitsubishi Electric Corp.
- 10:50 Gate oxide reliability of 4H-SiC V-groove trench MOSFET under various stress conditions [ISPSD]
T. Hiyoshi, K. Uchida, M. Sakai, M. Furumai, T. Tsuno, Y. Mikamura
Sumitomo Electric Industries
- 11:15 High-speed switching and current-collapse-free operation by GaN gate injection transistors with thick GaN buffer on bulk GaN substrates [IEDM]
H. Handa, S. Ujita, D. Shibata, R. Kajitani, N. Shiozaki, M. Ogawa, H. Umeda, K. Tanaka, S. Tamura, T. Hatsuda, M. Ishida, T. Ueda
Panasonic Corp.

— 昼食 [11:40 - 13:00] —

Session II. Sensor, Solar Cell, and Emerging Devices [13:00-13:50]

座長：佐々 誠彦（大阪工業大学）

- 13:00 High-mobility TFT and enhanced luminescence utilizing nucleation-controlled GeSn growth on transparent substrate for monolithic optoelectronic integration [IEDM]
H. Oka, M. Koyama, T. Tomita, T. Amamoto, K. Tominaga, S. Tanaka, T. Hosoi, T. Shimura, H. Watanabe
Osaka Univ.
- 13:25 Electroluminescence emission patterns of organic light-emitting transistors based on crystallized fluorene-type polymers [AM-FPD]
H. Kajii, T. Ohtomo, Y. Ohmori
Osaka Univ.

— 休憩 [13:50 - 14:10] —

Session III. CMOS Process, Device, and Circuit [14:10-15:25]

座長：鎌倉 良成（大阪大学）

- 14:10 Anomalous TDDDB statistics of gate dielectrics caused by charging-induced dynamic stress relaxation under constant-voltage stress [IEEE T-ED]
K. Okada, K. Kurimoto, M. Suzuki
TowerJazz Panasonic Semiconductor Company
- 14:35 Charge effects of ultrafine FET with nanodot type floating gate [AM-FPD]
T. Ban, S. Migita¹, Y. Uraoka², S. Yamamoto
Ryukoku Univ., ¹AIST, ²NAIST

15:00 **A self-biased low-dropout linear regulator for ultra-low power battery management [SSDM]**
T. Ozaki, T. Hirose, H. Asano, N. Kuroki, M. Numa
Kobe Univ.

AWARD授与 [15:25-15:45]

上田 尚宏 (リコー電子デバイス)

閉会挨拶 [15:45-15:50]

中村 孝 (ローム)